



V1.1

中科海高
HiGaAs Microwave

HGC139-8

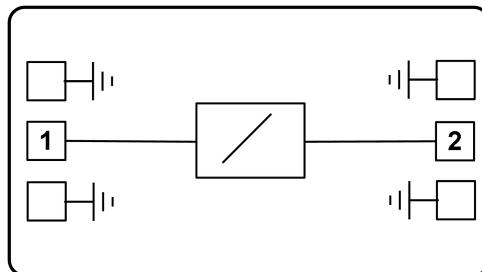
GaAs MMIC
均衡器芯片, 0.2 - 2 GHz

6

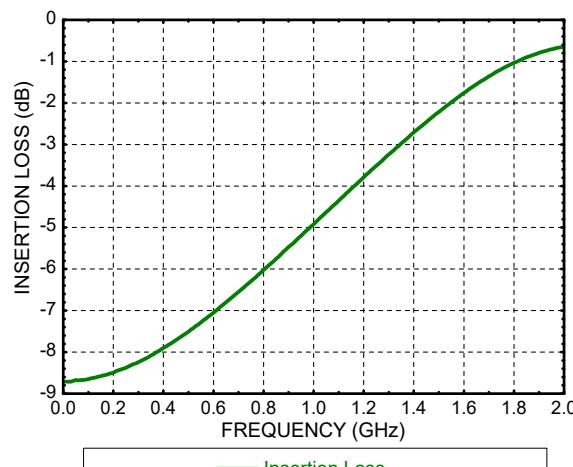
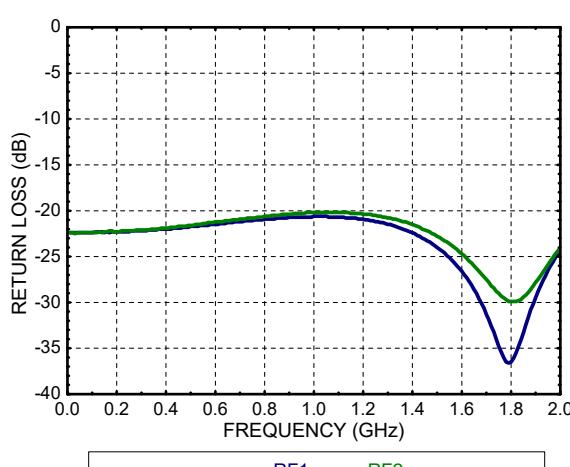
**均衡器
| 裸芯片**

主要特点

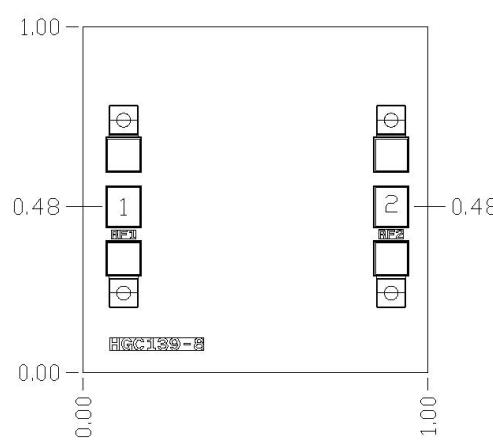
频率范围: 0.2 - 2 GHz
插入损耗: 0.7 dB @ 2 GHz
均衡量: 8 dB
回波损耗: 22 dB
芯片尺寸: $1.0 \times 1.0 \times 0.1 \text{ mm}^3$

功能框图**性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)**

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围		0.2-2		GHz
插入损耗@2GHz		0.7		dB
均衡量		8		dB
回波损耗		22		dB

插入损耗**回波损耗****物理参数**

单位: mm

**焊盘描述**

焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是射频输入/输出端口
2	RF2	该焊盘是射频输入/输出端口



V1.1

中科海高
HiGaAs Microwave

HGC139-8

GaAs MMIC
均衡器芯片, 0.2 - 2 GHz

6

均衡器 - 裸芯片

注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100 μm^2
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度：
0.5+1.6 μm

极限参数

1. 射频输入功率：+30dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150°C
3. 工作温度：-55 ~ +85°C